



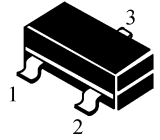
# 桂林斯壯微電子有限責任公司

## Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMBTA44(銷售型號 MMBTA44)

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



### FEATURES 特點

NPN High Voltage Transistor

### MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-射極電壓	$V_{CEO}$	400	V
Collector-Base Voltage 集電極-極電壓	$V_{CBO}$	400	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	$V_{EBO}$	7	V
Collector Current 集電極電流	$I_c$	200	mA
Device Dissipation 耗散功率	$P_D$	225	mW
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_j, T_{stg}$	-55to+125	°C

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^{\circ}C$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^{\circ}C$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-射極擊穿電壓( $I_C=1mA, I_B=0$ )	$V_{(BR)CEO}$	400	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓( $I_C=100\mu A, I_E=0$ )	$V_{(BR)CBO}$	400	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓( $I_E=100\mu A, I_C=0$ )	$V_{(BR)EBO}$	7	—	V
Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ( $V_{CB}=300V, I_E=0$ )	$I_{CBO}$	—	500	nA
DC Current Gain 直流電流增益 ( $I_C=10mA, V_{CE}=10.0V$ )	$H_{FE}$	40	300	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降 ( $I_C=100mA, I_B=10mA$ )	$V_{CE(sat)}$	—	0.5	V
Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益帶寬乘積 ( $I_C=10mA, V_{CE}=20V, f=30MHz$ )	$f_T$	50	—	MHz



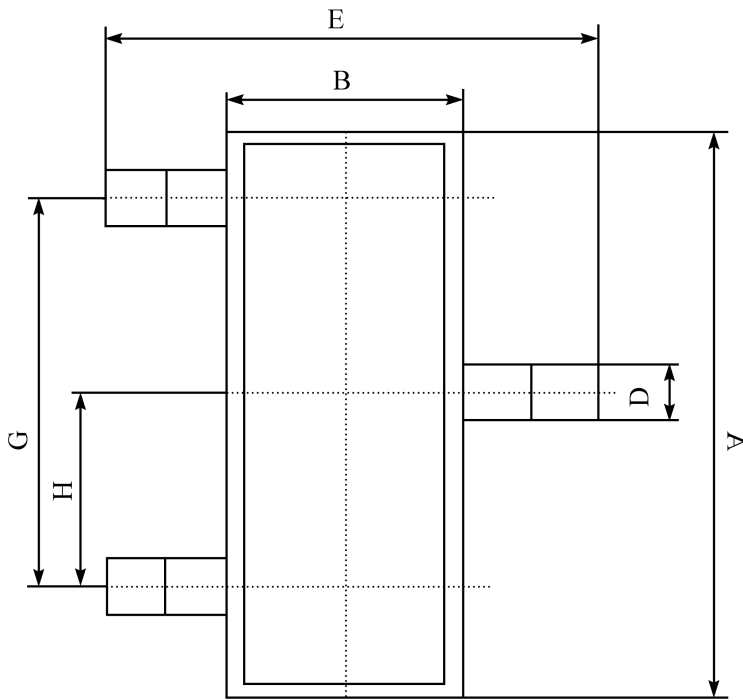
GMBTA44(銷售型號 MMBTA44)

■**DEVICE MARKING** 打標

GMBTA44(銷售型號 MMBTA44)=3D

■**DIMENSION** 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°

